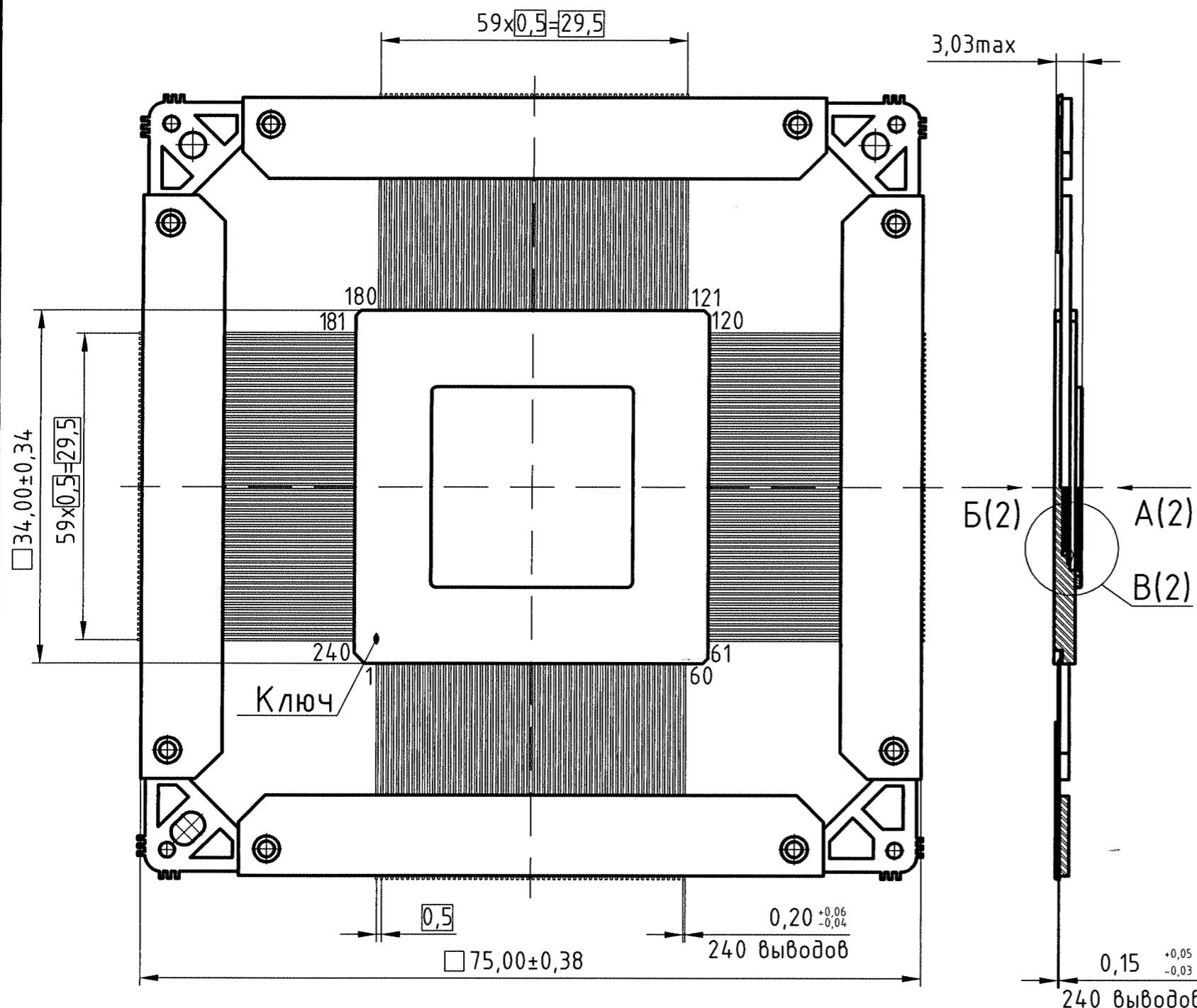


Г АВЛ.431268.019СБ

Рис.1 (Г АВЛ.431268.019)

(см. продолжение на листах 2, 3)



1. Размеры для справок.
2. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
3. Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
4. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Д - максимальная стрела прогиба проводника.
5. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки по РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания и наплыв металла по контуру крышки.
6. Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен быть не более $6,65 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{см}^3 / \text{с}$.
7. Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида Г АВЛ.431269.045Д2.
8. Маркировать составом маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ОСТ В 11 0998 Дк, Шк, Нк, ОП, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,5 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, Кк, знак Δ согласно виду А для микросхемы 5529ТР084 и согласно основному виду для микросхемы 5529ТР084А. Допускается использовать состав маркировочный эпоксидный черный МКЭЧ РМ11.028.002-83.
Допускается маркировка крышки методом лазерной гравировки на глубину не более 1,5 мкм и маркировка основания корпуса методом лазерной гравировки на глубину не более 30 мкм.
9. С обратной стороны маркировать согласно виду Б для микросхемы 5529ТР084, виду Ж для 5529ТР084А.
10. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
11. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
12. В зоне Шк маркировать согласно таблице 1.
13. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.
14. Допускается нанесение клейма ВП и клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
15. Нумерация выводов приведена условно.

16. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии 5529ТР084 соответствует данным этикетки Г АВЛ.431268.019ЭТ, 5529ТР084А - Г АВЛ.431268.019-01ЭТ.
17. Исполнения микросхем приведены в таблице 1.

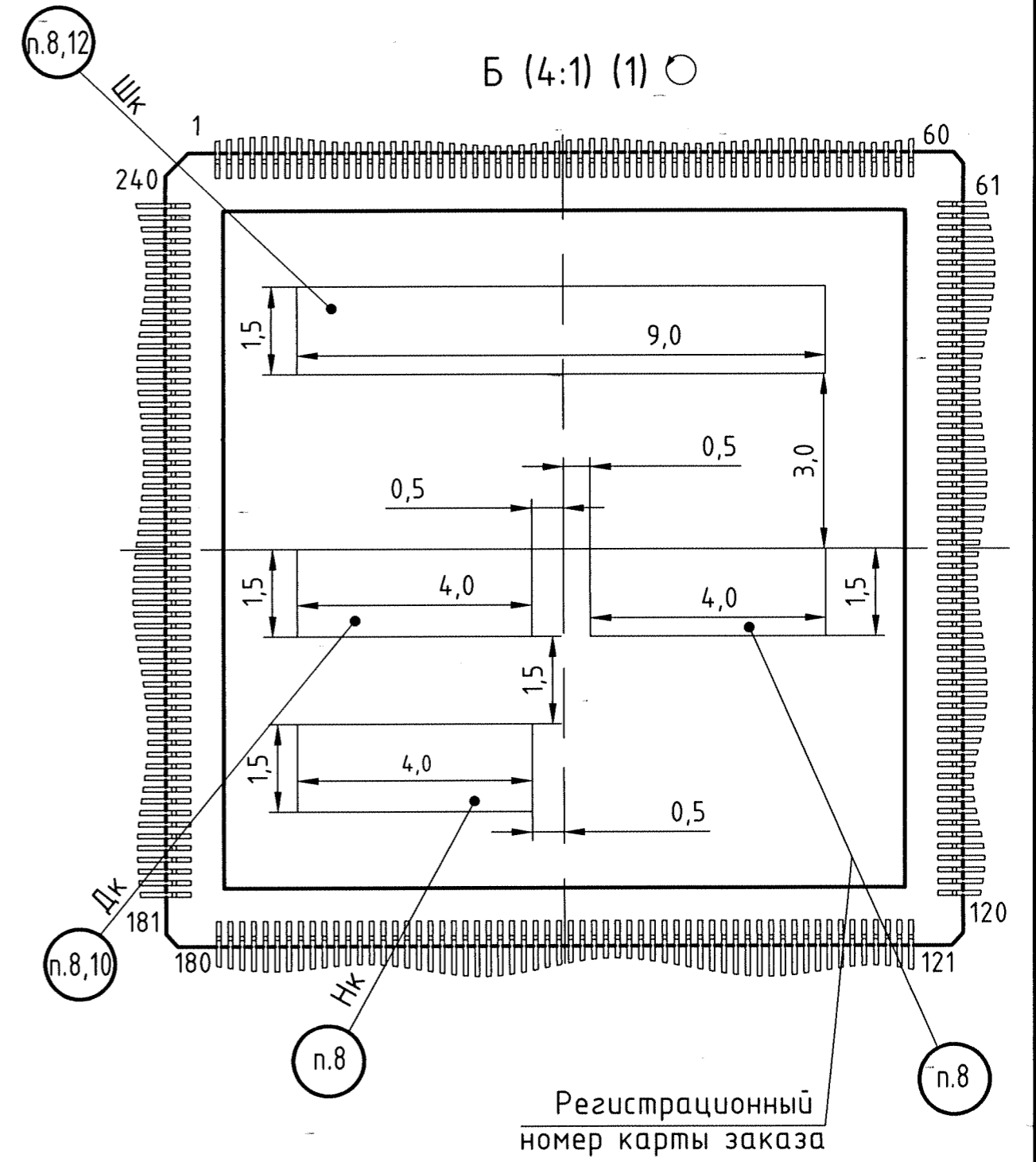
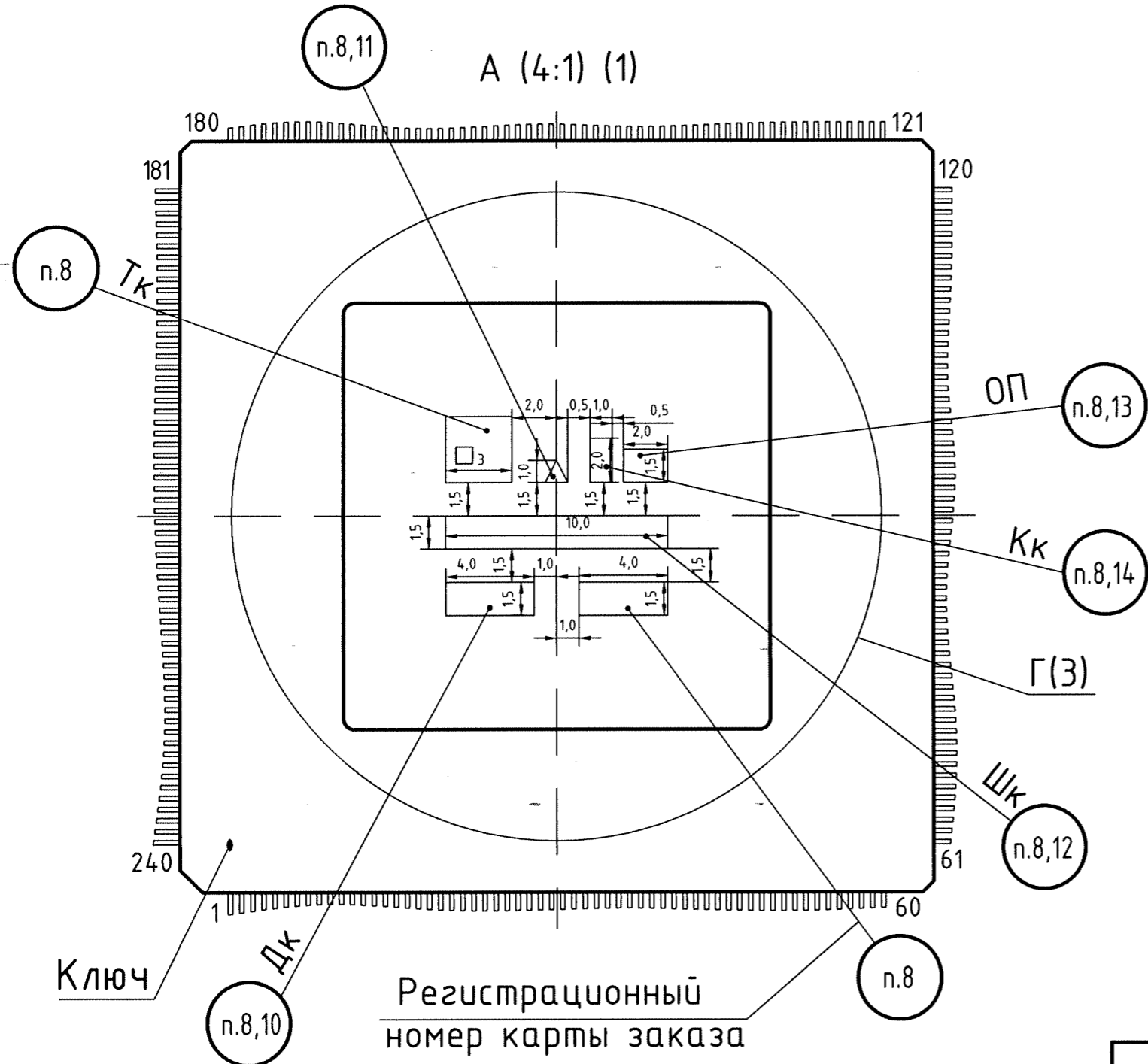
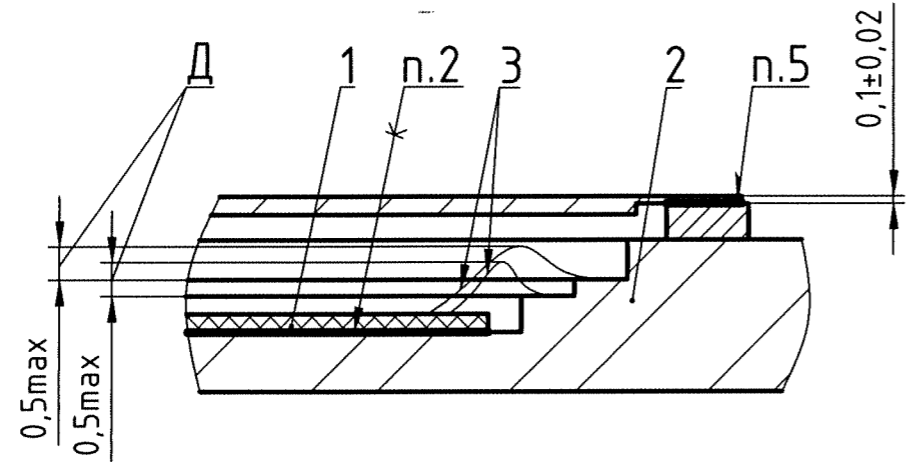
Таблица 1- Модификация

Обозначение	Наименование изделия	Корпус	Маркировка Шк	Масса	Рис.
Г АВЛ.431268.019	5529ТР084	МК 4245.240-7	5529ТР084	max 18,0 г	1
-01	5529ТР084А	МК 4250.208-2	5529ТР084А	max 16,0 г	2

Г АВЛ.431268.019СБ					
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Подп.	Дата	Микросхемы интегральные 5529ТР084, 5529ТР084А Сборочный чертеж
Изм	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	
Разраб.	Астахова			13.11.19	
Пров.	Тукашкин			13.11.19	
512 ВП	Чириченко			5.12.19	Лист 1 Листов 6
Н.контр.	Казаков			13.11.19	
Утв.	Денисов			13.11.19	

Перв. примен. Г АВЛ.431268.019
Справ. №
Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл
Подп. и дата
Инв. № подл.

Рис.1 (продолжение)
(Г АВЛ.431268.019)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
159а	Дюф 22.01.20			

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Дюф	22.01.20
Изм/Лист	Докум.	Подп.	Дата	

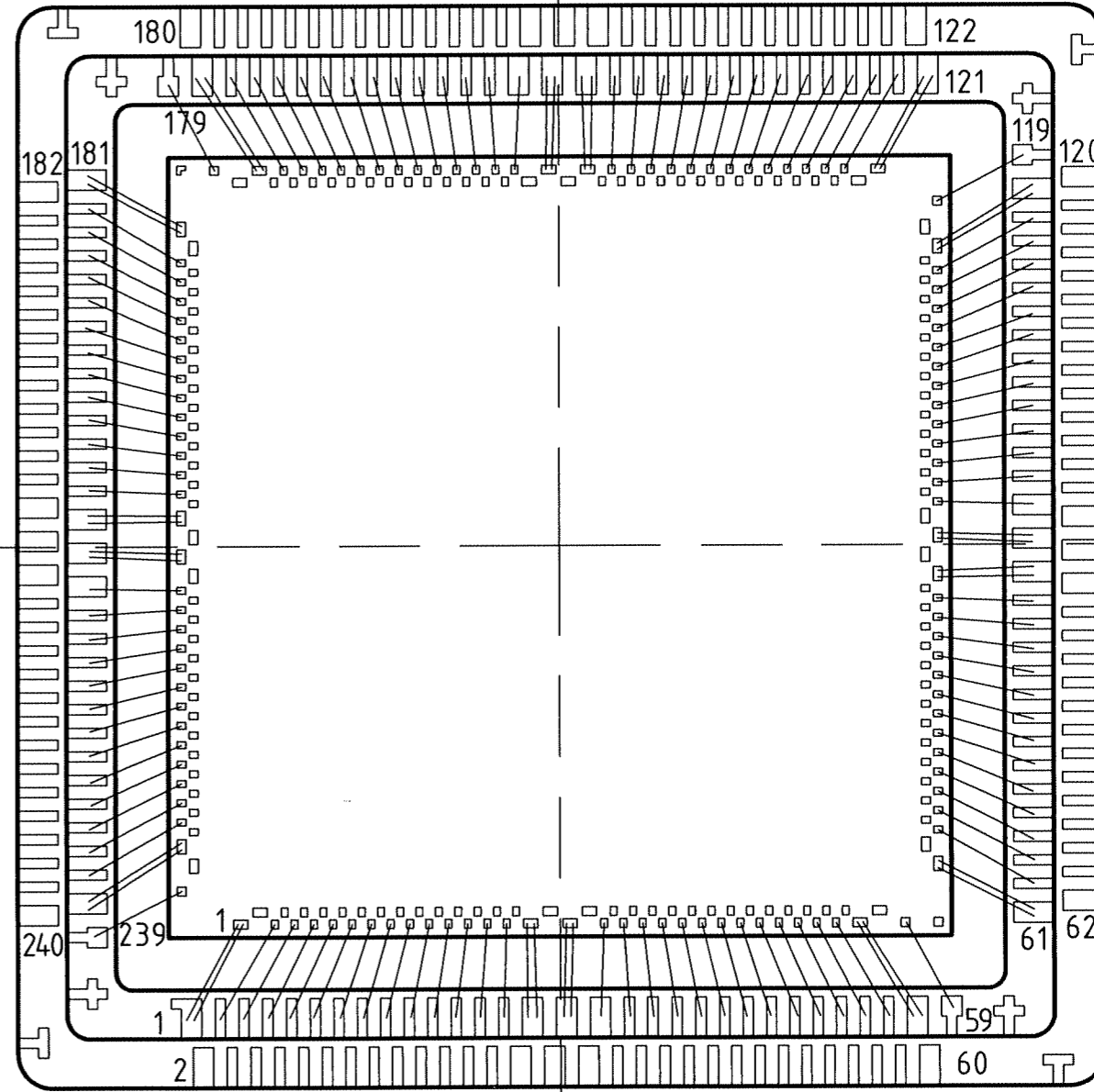
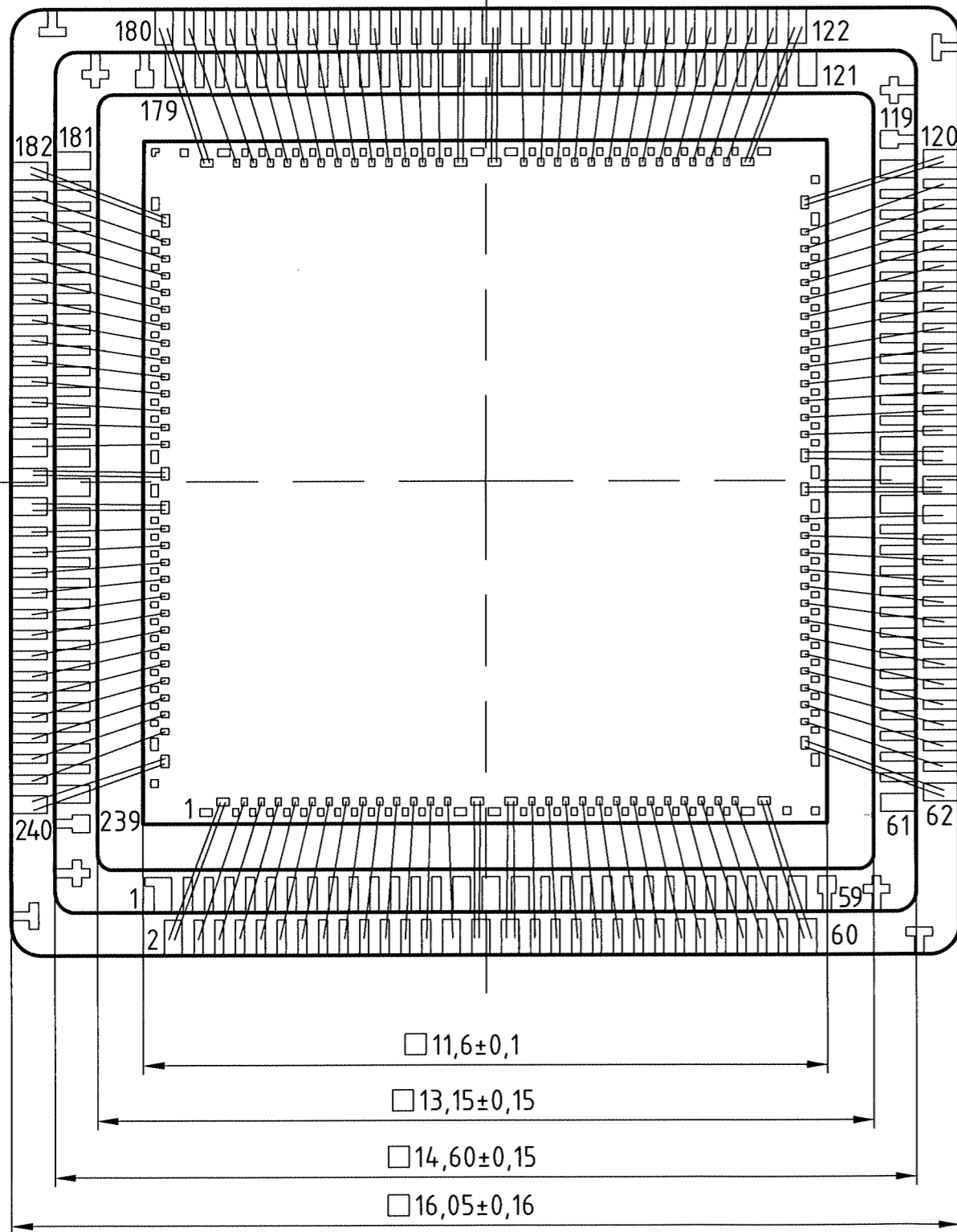
Рис.1 (продолжение)
(Г АВЛ.431268.019)

Г (10:1) (2)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны, показана разварка на внешние площадки колодца

Г (10:1) (2)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны, показана разварка на внутренние площадки колодца



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл	Подп. и дата
159d	Лит АА.01.00			

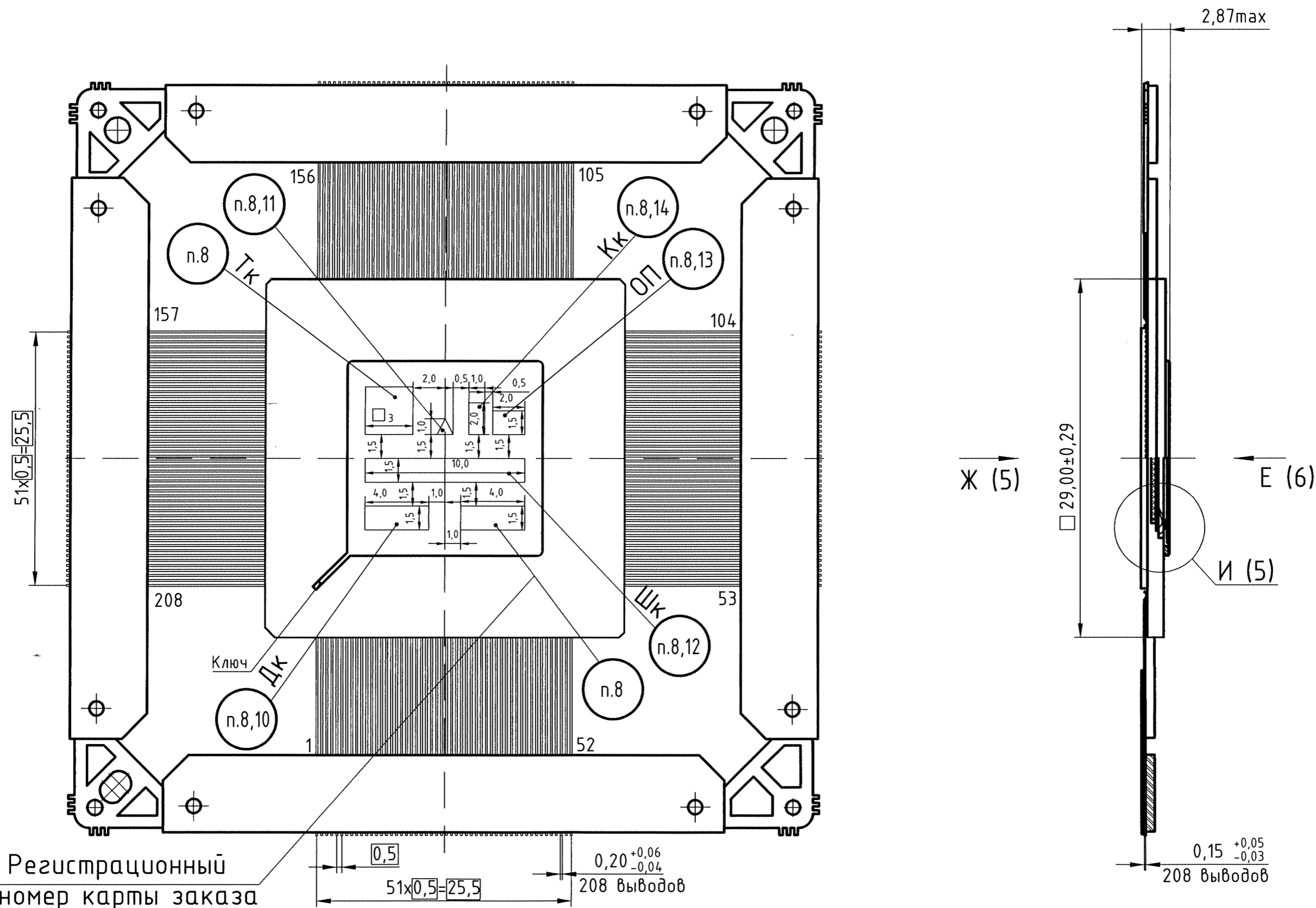
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>[Signature]</i>	09.09.19
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата

Г АВЛ.431268.019СБ

Лист
3

Рис.2 (Г АВЛ.431268.019-01)

(см. продолжение на листах 5, 6)



Регистрационный номер карты заказа

0,5
51x0,5=25,5
0,20^{+0,06}/_{-0,04}
208 выводов

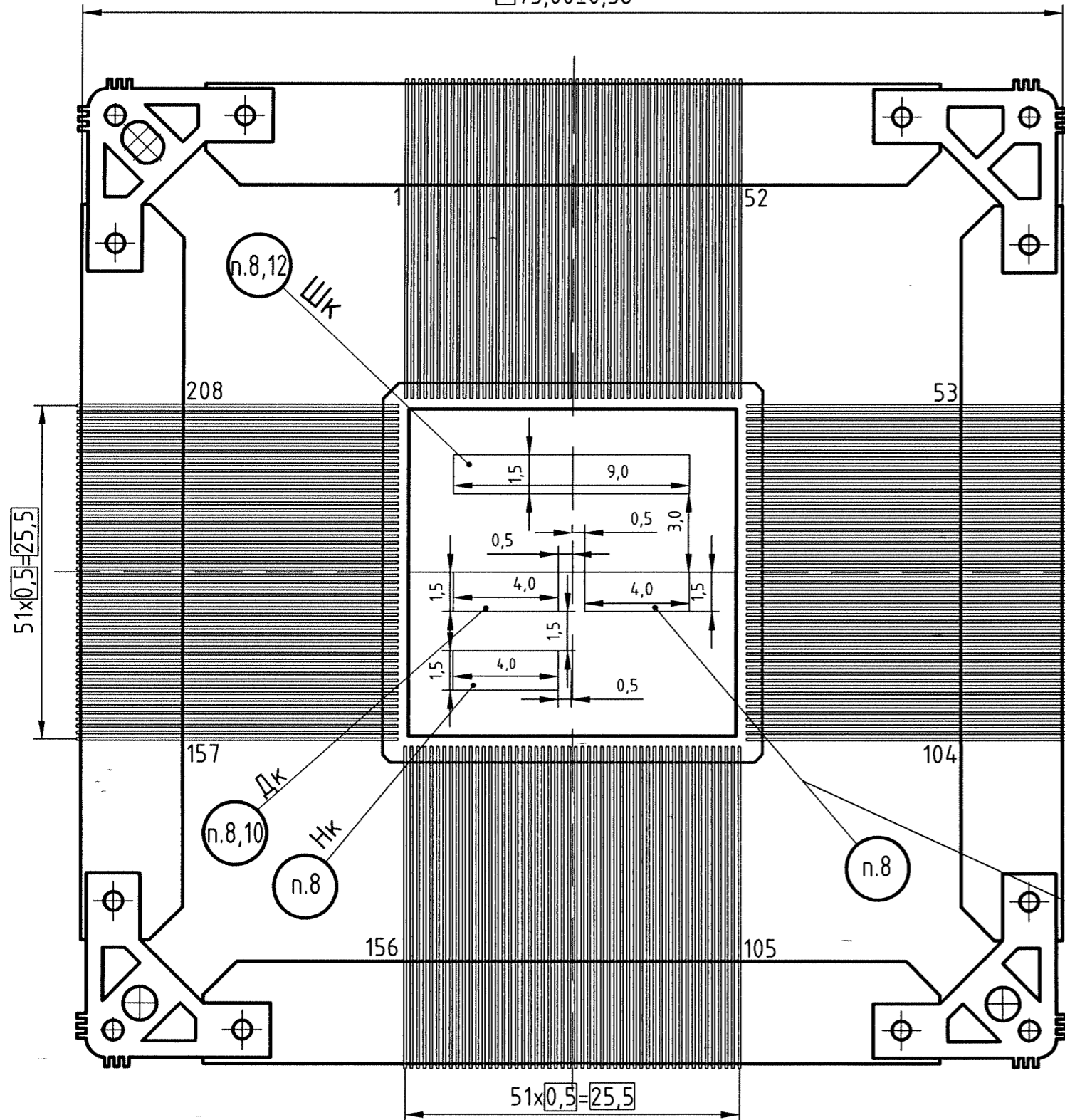
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
159д	22.01.20			

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019				Г АВЛ.431268.019СБ	Лист
Изм./Лист	Докум.	Подп.	Дата				4

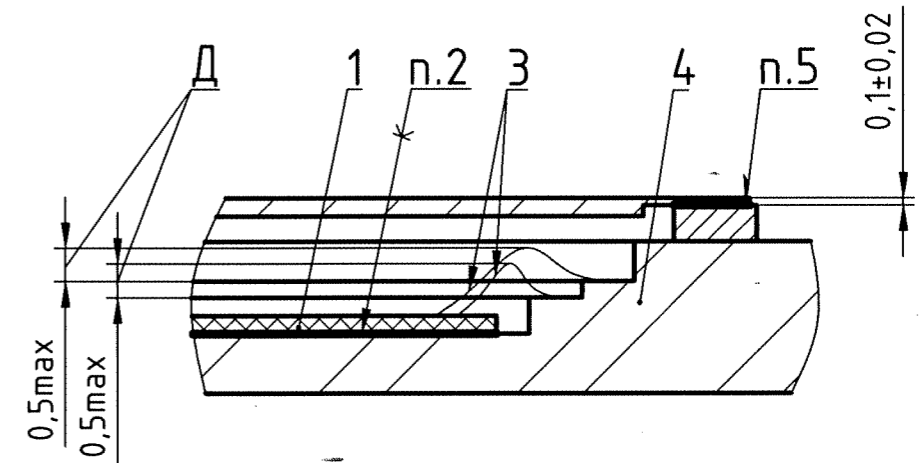
Рис.2 (продолжение)
(ГВЛ.431268.019-01)

Ж (4) ○

□75,00±0,38



И (10:1) (4) ○



Регистрационный
номер карты заказа

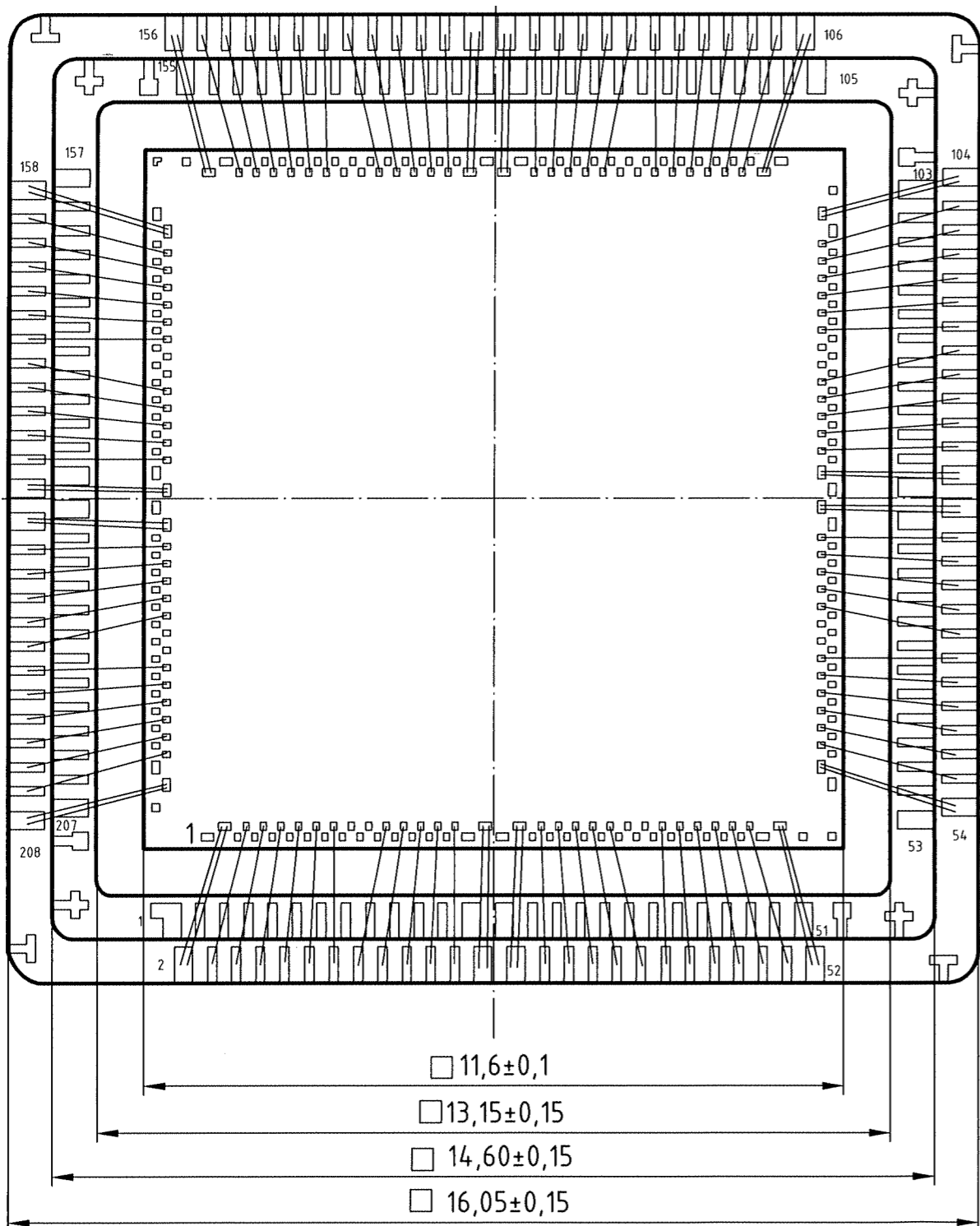
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
1094	Сид. Сид. 01.01			

1	Зам.	ГВЛ.09-2019	Сид	01.01.19
Изм/Лист	Докум.	Подп.	Дата	

Рис.2 (продолжение)
(Г АВЛ.431268.019-01)

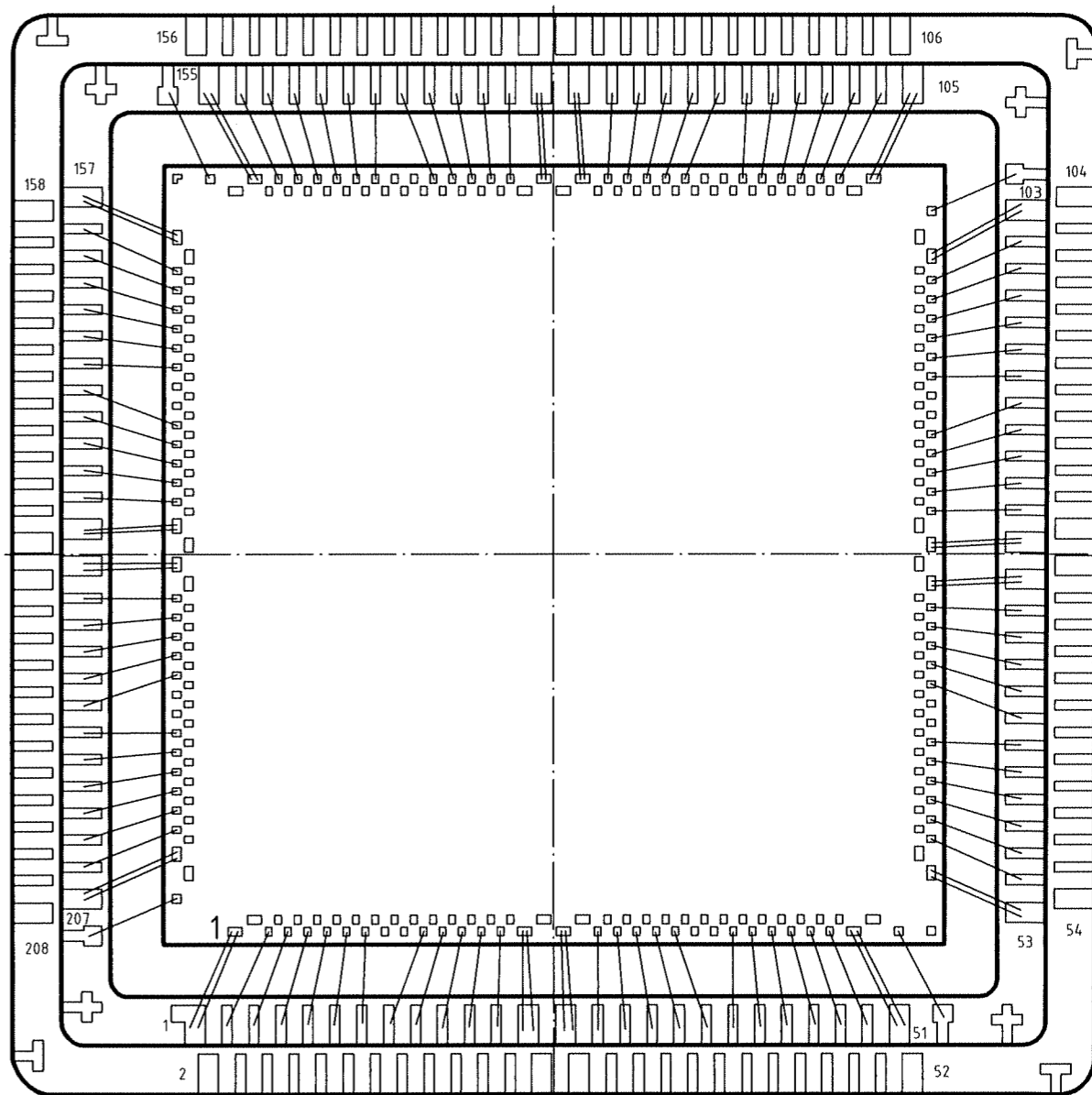
Е (10:1) (4)

Крышка и внешние выводы
микросхемы не показаны,
показана разварка на вне-
шние площадки колодца



Е (10:1) (4)

Крышка и внешние выводы
микросхемы не показаны,
показана разварка на внут-
ренние площадки колодца



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
1592	<i>С.И.С.</i>			<i>С.И.С.</i>

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>С.И.С.</i>	<i>С.И.С.</i>
Изм./Лист	Докум.	Подп.	Дата	